Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0116U006421

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-06-2016

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201380

У тому числі по роках:	
2016	0 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 60 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи: Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444813221, 380444814763

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Оксидні матеріали з високою діелектричною сталою, що містять нанокластери кремнію або германію, для застосування в мікроелектроніці та фотоніці

Назва роботи англійською:

High-k oxides doped with Si or Ge nanoclusters for microelectronic and photonic applications

Мета роботи українською:

Встановлення природи фізичних процесів, які відбуваються при термічному розпаді Si(Ge)-HfO2 та Si(Ge)-Al2O3 твердих розчинів, з'ясування механізмів формування Si і Ge нанокластерів та нанокристалів в оксидних матрицях з високою діелектричною сталою та визначення технологічних підходів для контролю за структурними, оптичними та електричними властивостями таких матеріалів для застосування в приладах мікро- і фотоелектроніки.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: 72.19

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Хоменкова Лариса Юріївна

Науковий ступінь:

Наукове звання:

Ідентифікатор ORCHID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження впливу стехіометрії матеріалів Ge-Al2O3 на утворення напівпровідникових нанокластерів та впливу цього процесу на структурні, оптичні та електричні властивостей шарів

Початок етапу: 06.2016

Закінчення етапу: 09.2016

Вид звітного документа: Проміжний звіт

Номер етапу: 2

Назва етапу: Дослідження впливу стехіометрії матеріалів Ge-HfO2 на утворення напівпровідникових нанокластерів та впливу цього процесу на структурні, оптичні та електричні властивостей шарів

Початок етапу: 10.2016

Закінчення етапу: 12.2016

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 537.226;537.311.32;538.956, 538.9

Коди тематичних рубрик: 29.19.33

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Бєляєв Олександр Євгенович
д. ф.-м. н., 01.04.10

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.